



بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و  
فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس  
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،  
دانشگاه شیراز،  
شیراز، ایران.  
۱۱-۹ بهمن ۱۳۹۷



## تولید باریکه‌ی بسل با استفاده از ماسک فازی مبتنی بر بلور مایع

حبیب خوش سیما<sup>۱</sup>، فرزانه پناهی شالغونی<sup>۱</sup> و محمد یگانه<sup>۲</sup>

<sup>۱</sup> پژوهشکده‌ی فیزیک کاربردی و ستاره‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز

<sup>۲</sup> دانشکده‌ی فیزیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه‌ی زنجان، زنجان

khoshsima@tabrizu.ac.ir, farzan.p.70@gmail.com, moyeganeh@iasbs.ac.ir

چکیده - شیوه‌های گوناگونی برای ساخت باریکه‌ی بسل ارائه شده است. یکی از ساده‌ترین این روش‌ها، ایجاد توزیع حلقوی نور است. در این مقاله، روش تجربی برای ساخت باریکه‌ی بسل با استفاده ماسک لیتوگرافی شده به شیوه‌ی ثبت الگو بر بلورمایع آلائیده با رنگینه‌ی آزو متیل‌رد ارائه شده است. برای حصول بهترین نتیجه، از لیزری با طول موج ۵۳۲ نانومتر برای ثبت این الگو استفاده شده است. طبق مشاهدات انجام شده، با اعمال میدان الکتریکی به سلول بلورمایع برای باریکه‌ی نور قطبیده‌ی خطی، باریکه‌ی بسل تولید شد.

کلید واژه- اپتیک فوریه، باریکه‌ی بسل، بلور مایع، پالایه‌ی فضایی.

## Generation of Bessel beam using phase mask based on liquid crystal

Habib Khoshsima<sup>\*1</sup>, Farzaneh Panahi Shalghoni<sup>1</sup>, and Mohammad Yeganeh<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Research Institute for applied physics and astronomy, Tabriz University, Tabriz, Iran

<sup>2</sup>Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basic Sciences, Zanjan, Iran.

**Abstract-** Various methods have been developed for construction of the Bessel beam. One of the simplest methods is generating an annual distribution of light. In this paper, an experimental method for the production of Bessel beam using a lithographic mask based on azo methyl red-doped liquid crystal is presented. In order to obtain the best result, a 532nm laser was used to recording the pattern. According to observation, by applying the electric field to the liquid crystal cell for linearly polarized light, the Bessel beam was produced.

**Keywords:** Fourier optics, Bessel beam, liquid crystal, spatial filter.

$$E(r, \varphi, z) = A \exp(ik_z z) J_0(k_r r), \quad (1)$$

که در آن  $r$  و  $\varphi$  به ترتیب مختصات شعاعی و سمتی هستند.  $z$  مختصه‌ی در راستای انتشار باریکه است.  $k_z$  و  $k_r$  به ترتیب مؤلفه‌های طولی و شعاعی بردار موج هستند. در این رابطه، از مراتب بالاتر تابع بسط صرف نظر کرده‌ایم. توزیع شدت الگوی بسط (مرتبه‌ی صفر)، حلقه‌های هم‌مرکزی است که دارای یک لوب مرکزی پرشدت است.

الگوی ماسک مورد نظر در شکل ۱ نشان داده شده است که با استفاده از تبدیلات فوریه، موج تخت ورودی را به باریکه‌ی بسط در خروجی تبدیل می‌کند. اگر پراش از میدان ورودی  $u_i(r') = A \delta(r' - a)$  ( $\delta$  تابع دیراک است) که حلقه‌ای نازک به شعاع  $a$  است را در نظر بگیریم، برای میدان پراش‌یافته‌ی آن در فاصله‌ی  $z$  خواهیم داشت [۹]:

$$u_d(r; z) = \frac{2\pi i}{\lambda z} e^{-ik_z z} e^{\frac{-i\pi(r^2+a^2)}{\lambda z}} a A J_0\left(\frac{2\pi a r}{\lambda z}\right), \quad (2)$$

که متناسب با تابع بسط مرتبه‌ی صفر است. از آنجا که در عمل ایجاد توزیع میدان حلقوی ایده‌آل با تابعیت شعاعی دلتای دیراک غیرممکن است، از یک سیستم  $4f$  مطابق شکل ۲ که از دو عدسی تشکیل شده است کمک می‌گیریم. در نهایت تبدیلات دو مرحله‌ای در سیستم  $4f$  از صفحه‌ی جسم با توزیع دایره‌ای یکنواخت به شعاع  $a$  تا صفحه‌ی تصویر را به شکل زیر می‌توان نوشت:

$$u_i(r) = \frac{4\pi^2}{\lambda^2 f^2} \times \int_{p_1}^{p_2} r' dr' J_0\left(\frac{2\pi r r'}{\lambda f}\right) \int_0^a r'' dr'' J_0\left(\frac{2\pi r' r''}{\lambda f}\right), \quad (3)$$

$p_1$  و  $p_2$  به ترتیب شعاع خارجی و شعاع داخلی ماسک حلقه‌ای شکل قرار گرفته در صفحه‌ی فوریه است. مختصات  $r'$ ،  $r''$  و  $r$  به ترتیب مربوط به مختصات شعاعی در صفحه‌ی تصویر، صفحه‌ی فوریه و صفحه‌ی جسم است.

## مقدمه

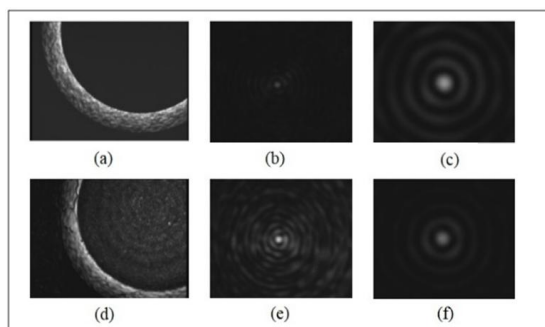
باریکه‌ی بسط جزو باریکه‌های غیر پراشی است، از این رو ویژگی‌های ممتازی نسبت به باریکه‌های دیگر دارد. قابلیت خود ترمیمی و واگرایی کمتر آن در انتشار، کاربردهای بسیار مهمی در زمینه‌های مختلف همانند انبرک نوری [۱]، تله‌اندازی نوری [۲]، ارتباطات نوری در فضای آزاد، میکرولیتوگرافی [۳] و توموگرافی نوری [۴] برای آن ایجاد کرده است. شعاع لوب مرکزی این باریکه می‌تواند از مرتبه‌ی طول موج نور باشد که از مزیت‌های آن برای کاربردهای ذکر شده است. باریکه‌های بسط را می‌توان به وسیله‌ی عدسی مخروطی (آکسیکون) [۵]، ایجاد حلقه‌ی نوری [۶]، ماسک دامنه‌ای یا فازی، صفحات هولوگرافی [۷]، تیغه‌ی منطقه‌ای فرنل [۸]، تحریرگر فضایی نور (SLM) و غیره تولید کرد. از آنجا که تبدیل فوریه‌ی فضایی یک حلقه، تابع بسط ایجاد می‌کند، در اینجا با ایجاد حلقه‌ی نوری و انتشار آن، باریکه‌ی بسط ایجاد نمودیم که ساده‌ترین روش تولید آن است.

سلول بلورمایع به دلیل ساخت آسان و قابلیت کنترل‌پذیری خواص نوری‌اش با اعمال ولتاژهای پایین، گزینه‌ی مناسبی برای ایجاد حلقه‌ی نوری در تولید باریکه‌ی بسط است. با افزودن رنگینه‌ی آزو به سلول بلورمایع، بستری برای ثبت الگوی حلقه‌ی روشن از طریق روش ذخیره‌سازی می‌توان ایجاد کرد. اعمال میدان الکتریکی سبب بازجهت‌گیری مولکول‌های بلورمایع شده و با ایجاد اختلاف فاز بین ناحیه‌ی تاریک و روشن در سلول، سبب تولید باریکه‌ی بسط می‌گردد. در این کار از سیستم  $4f$  به منظور ایجاد کمترین انحراف و واگرایی باریکه در طول انتشار نیز استفاده گردید [۹].

## مبانی نظری

موج بسط به موجی گفته می‌شود که توزیع عرضی میدان الکتریکی آن نسبت به راستای انتشار توسط تابع مرتبه‌ی صفر بسط ( $J_0$ ) تعریف شود:

فرکانس‌های پایین و عبور فرکانس‌های بالاتر شده و پس از عبور از عدسی دوم و گرفتن تبدیل عکس فوریه توسط آن، باریکه‌ی حلقوی نازکی ایجاد می‌کند و در نهایت با انتشار آن، باریکه‌ی بسل شکل می‌گیرد.



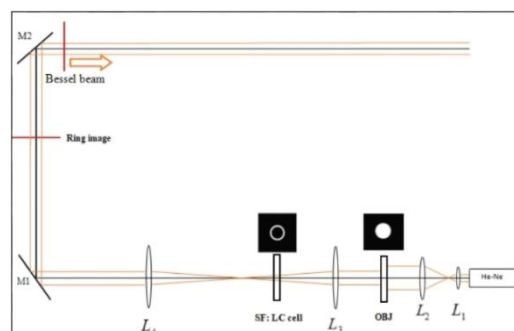
شکل ۳: بالا: تصاویر خروجی مربوط به ماسک، پایین: تصاویر خروجی مربوط به سلول بلورماید. (a) و (d) تصویر الگوی حلقوی تولید شده در فاصله‌ی ۱۱۵ سانتی‌متری از عدسی دوم، (b) و (e) باریکه‌ی بسل تولید شده در اولین مکان پس از انتشار در فاصله‌ی ۱۷۵ سانتی‌متری از عدسی دوم. (c) و (f) باریکه‌ی بسل تولید شده در فاصله‌ی ۳۱۵ سانتی‌متری از عدسی دوم.

### کارهای تجربی

برای ساخت سلول بلورماید، از سلول آماده با ضخامت ۲۰ میکرون استفاده گردید که دارای یک لایه ITO به‌عنوان الکتروود شفاف و یک لایه‌ی شیاردار میکرونی برای ایجاد شیار و نظم‌دهی به مولکول‌های بلورماید بود. بلور ماید مورد استفاده در این سلول، 1294-1b با دوشکستی  $\Delta n = 0.312$  و ضریب شکست عادی  $n_o = 1.501$  و ضریب شکست غیرعادی  $n_e = 1.813$  بود. رنگینه‌ی آزو متیل‌رد به مقدار ۱ درصد وزنی مورد استفاده قرار گرفت. سلول به مدت یک ساعت در دمای  $70^\circ\text{C}$  و به مدت ۱۶ ساعت در دمای  $40^\circ\text{C}$  در کوره به منظور جای‌گیری مولکول‌های بلورماید و سرد شدن تدریجی قرار گرفت. ماسک مورد استفاده دارای قطر داخلی ۴ میلی‌متر و قطر خارجی ۵ میلی‌متر است. سپس سلول به همراه قرینه‌ی ماسک را در مقابل نور نویسنده که از لیزر پیوسته  $(\lambda = 532\text{nm})$  با توان  $20\text{mW}$  و با قطبش خطی p (قطبش موازی با شیارهای سلول) استفاده شد، به مدت

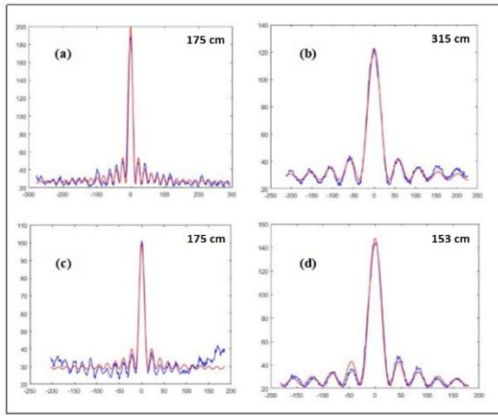


شکل ۱: (الف) طرح ماسک مورد نظر، (ب) قرینه‌ی ماسک ثبت طرح



شکل ۲: چیدمان تجربی: عدسی‌های  $L_1$  و  $L_2$  برای موازی سازی لیزر،  $L_3$  و  $L_4$  با  $f=50\text{cm}$  برای ایجاد سیستم  $4f$ .

ترکیبات آزو، به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود می‌تواند به دو شکل ایزومری سیس و ترانس ظاهر شوند. با تابش نور در محدوده‌ی طیف جذبی رنگینه‌ها، احتمال وقوع فوتوایزومریزاسیون ترانس-سیس-ترانس شکل می‌گیرد. پس از طی چرخه‌های متوالی، بردار راهنمای مولکول‌ها عمود بر قطبش نور ورودی خواهد شد و منجر به بازجهت‌گیری رنگینه‌های آزو خواهد گردید و این بازجهت‌گیری روی مولکول‌های بلورماید، گشتاوری وارد می‌کند و در نهایت باعث بازجهت‌گیری مولکول‌های بلورماید نیز می‌شود. با ثبت طرح حلقه بر روی سلول بلورماید به شیوه‌ی ثبت الگو، سطح سلول دارای نواحی تاریک و روشن می‌شود و در نواحی نوردهی‌شده، مولکول‌ها عمود بر نظم سلول اولیه (HG) قرار می‌گیرند و به دلیل دوشکستی بالا در مولکول‌های بلورماید، اختلاف فاز بین دو ناحیه‌ی تاریک و روشن ایجاد می‌شود [۱۰]. پس از شکل‌گیری این الگو روی سلول و اعمال میدان الکتریکی به آن، اختلاف فاز ایجاد شده برای نور قطبیده‌ی خطی که راستای قطبش آن موازی با مولکول‌های روی حلقه است، تغییر می‌کند. اختلاف فاز بین این دو ناحیه باتوجه به اصل پراش و تبدیلات فوریه، باعث سد



شکل ۴: نمودارهای توزیع شدت باریکه‌های بسل در فواصل انتشاری مختلف. در ردیف بالا از ماسک و پایین سلول بلورماید استفاده شده.

### مرجع‌ها

- [1] L. A. Ambrosio, M. Zamboni-rached, H. E. Hernández-figueroa, and I. Senior, "Manipulating Gradient Forces on Optical Tweezers using Bessel Beams", Microwave and Optoelectronics Conference, IMOC 2007. SBMO/IEEE MTT-S International, No. 1, 2007.
- [2] B. Shao, S. C. Esener, J. M. Nascimento, E. L. Botvinick, and M. W. Berns, "Dynamically adjustable annular laser trapping based on axicons," *App. Opt.*, Vol. 45, 2006.
- [3] M. Erdelyi, et al, "Generation of diffraction-free beams for applications in optical microlithography", *J. Vac. Sci. and Technol. B*, Vol. 15, 1997.
- [4] Z. Ding, H. Ren, Y. Zhao, J. S. Nelson, and Z. Chen, "High-resolution optical coherence tomography over a large depth range with an axicon lens", *Opt. Lett.*, Vol. 27, 2002.
- [5] G. Scott and N. McArdle, "Efficient generation of nearly diffraction-free beams using an axicon", *Opt. Eng. Bellingham* Vol. 31, 1992.
- [6] I. Abdo, N. Ashry, M. Sadek, M. A. Hakim, and D. Khalil, *Effect of ring width on ring generated Bessel beam*, p. 823608, Proc. SPIE, 2012.
- [7] A. Vasara, J. Turunen, and A. T. Friberg, "Holographic generation of diffraction-free beams", *Appl. Opt.*, Vol. 27, 1988.
- [8] Arash Sabatyan and Bahar Meshgingalam, "Generation of annular beam by a novel class of Fresnel zone plate", *Appl. Opt.*, Vol. 53, 2014.
- [9] J. M. D. Kowalczyk, S. N. Smith, and E. B. Szarmes, "Generation of Bessel beams using a 4-f spatial filtering system," *Am. J. Phys.*, Vol. 77, 2009.
- [10] F. Moghadas, H. Khoshshima, and B. Olyaeefar, "High diffraction efficiency in permanent optical memories based on Methyl Red doped liquid crystal," *Opt. Quantum Electron.*, Vol. 47, 2014.

۱۷ ساعت به‌منظور ثبت طرح روی سلول قرار گرفت. در نهایت سلول آماده شده را در چیدمان سیستم 4f قرار دادیم. در این چیدمان از لیزر هلیوم-نئون با طول‌موج ۵۹۴ نانومتر (نارنجی) و توان ۱۷ میلی‌وات پس از پالایش فضایی و موازی کردن، که خارج از محدوده‌ی طیف جذبی رنگینه‌ی متیل‌رد است، استفاده کردیم. این لیزر در هنگام برخورد به جسم با توزیع شدت دایره‌ای به قطر ۵ میلی‌متر (OBJ) دارای قطر ۷ میلی‌متر است که به وسیله قطر جسم محدود می‌شود. همچنین، با افزودن قطبش‌گر به چیدمان، قطبش نور را موازی با شیارهای سلول قرار دادیم. با توجه به راستای قطبش، باریکه‌ی کاوشگر در ناحیه‌ی روی طرح حلقه  $n_e$  و در سایر نواحی،  $n_o$  را تجربه خواهد کرد. با اعمال میدان الکتریکی مربعی با فرکانس ۱/۵ کیلوهرتز به سلول، بردار راهنمای مولکول‌های بلورماید تغییر می‌کند [10]. با افزایش ولتاژ اعمالی مشاهده می‌شود که در ۵ ولت بازجهت‌گیری در سلول ایجاد شده و در فاصله‌ی ۱۱۵ سانتی‌متر از عدسی  $L_4$  الگوی حلقوی به‌طور کامل ایجاد می‌شود و پس از انتشار باریکه در فاصله‌ی ۱۷۵ سانتی‌متری عدسی  $L_4$  باریکه‌ی بسل شروع به شکل‌گیری می‌کند که این نتایج با حالتی که به‌جای سلول از معادل ماسک حلقوی آن استفاده می‌شد، مطابقت دارد. با افزایش ولتاژ کیفیت باریکه‌ی تشکیل شده بهتر می‌شود. برای مقادیر بالاتر از ۱۰ ولت، کیفیت باریکه‌ی تولیدی کاهش یافته و فقط روشنایی تصویر افزایش می‌یابد (شکل‌های ۳ و ۴).

### نتیجه‌گیری

در این کار تجربی، با روش ذخیره‌سازی، ساختار حلقوی از جهت‌گیری مولکول‌های بلورماید در سلول ایجاد گردید. با قرار دادن این سلول در چیدمان 4f، در خروجی، ساختار حلقه‌ی روشن ایجاد و با انتشار آن، باریکه‌ی بسل ایجاد شد. همچنین اثر ولتاژ بر باریکه‌ی بسل نیز بررسی گردید.